Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0402U000557

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-02-2002

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. ТАЛАНІН Віталій Ігорович

2. TALANIN Vitalij Igorovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 07-02-2002

Спеціальність за освітою: 7.090802

Місце роботи здобувача: Запорізька державна інженерна академія

Код за ЄДРПОУ: 05402565

Місцезнаходження: 69006, Запоріжжя, пр. Соборний, 226

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 17.051.04

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Запорізька державна інженерна академія

Код за ЄДРПОУ: 05402565

Місцезнаходження: 69006, Запоріжжя, пр. Соборний, 226

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.11

Тема дисертації:

1. Утворення, трансформація і властивості ростових мікродефектів у напівпровідниковому кремнію.

2. The formation, transformation and properties of grown-in microdefects in semiconducting silicon.

Реферат/анотація:

1. Об'єкт досліджень: механізм утворення, -трансформації мікродефектів, їх властивості у - напівпровідниковому Si. Мета: експериментальне. дослідження механізму утворення, росту і трансформації _ мікродефектів, їхнього впливу на характеристики монокристалів Si і приладових структур. Методи: селективне травлення, просвітлююча електронна мікроскопія, вимірювання електрофізичних параметрів монокристалів і електричних характеристик приладових -структур. Основні результати: виявлено співіснування. мікродефектів вакансійного і міжвузольного типів у Si незалежно від методу його вирощування. Встановлений гетерогенний механізм утворення і трансформації ростових мікродефектів. Досліджено зв'язок між утворенням мікрофедектів і наявністю фонових домішок.

2. Object of investigation: mechanism of microdefects formation, transformation and their properties in' semiconducting Si. Aim: experimental research of the mechanism of formation, growth and transformation of microdefects and their influence to performances of Si monocrystals and device compositions. Methods: selective etching, transmission electron microscopy, measurement of electrophysical parameters of monocrystals and

electrical performances of device structures. Main results: the -coexistence of vacancy and interstitial microdefects in Si irrespective of a method of its grown is revealed. The heterogeneous mechanism of grown-in microdefects formation and transformation is established. The communication between the microdefects formation and availability of background impurities is investigated.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Левінзон Давид Іделевич
2. Левінзон Давид Іделевич

Кваліфікація: д.т.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бахрушин Володимир Євгенійович,
2. Бахрушин Володимир Євгенійович,

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Головко Ольга Петрівна

2. Головко Ольга Петрівна

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Гіржон Василь Васильович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Гіржон Василь Васильович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.